

П307В, ОС

ЭТИКЕТКА

100

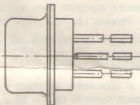
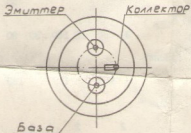


ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ П307ОС, П307ВОС,
П308ОС, П309ОС СООТВЕТСТВУЮТ
ГОСТ В 22468-77, СПЕЦИАЛЬНОМУ
ДОПОЛНЕНИЮ «АО.339.190ТУ, ЧАСТНЫМ
ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 3.365.059ТУ
И ДОПОЛНЕНИЮ № 6 3.365.059ТУ/Д6

Партия (извещение) № _____ от _____

349

201185



Масса не более 2 г.

Содержание драгметаллов в одном транзисторе

Золото

мг

10,7893

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{\text{окр.ср.}} = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	Н о р м а							
		ПЗ070С		ПЗ07ЮС		ПЗ080С		ПЗ090С	
		не- ме	не- се	не- ме	не- се	не- ме	не- се	не- ме	не- се
Обратный ток коллектора, мкА ($I_{\text{КБ}} = 80 \text{ В}$ $I_{\text{КБ}} = 120 \text{ В}$)	$I_{\text{КБ0}}$		3		3			3	3
Обратный ток эмиттера, мкА ($I_{\text{ЭБ}} = 3 \text{ В}$)	$I_{\text{ЭБ0}}$		5		5		5		5
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА ($R_{\text{ЭБ}} \leq 10 \text{ кОм}$, $I_{\text{КЭ}} = 80 \text{ В}$ $I_{\text{КЭ}} = 120 \text{ В}$)	$I_{\text{КЭВ}}$		20		20		20		20
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала ($I_{\text{КБ}} = 20 \text{ В}$, $I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}$)	$h_{21\text{в}}$	20	60	50	150	30	90	20	60
Сопротивление насыщения в режиме малого сигнала, Ом ($I_{\text{К}} = 15 \text{ мА}$, $I_{\text{Б}} = 3 \text{ мА}$)	$Z_{\text{КЭнас}}$		100		130		130		130
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($I_{\text{КБ}} = 20 \text{ В}$, $I_{\text{Э}} = 4 \text{ мА}$, $f = 10 \text{ МГц}$)	$ h_{21\text{в}} $	2		2		2		2	
Входное сопротивление транзистора в режиме малого сигнала, Ом ($I_{\text{КБ}} = 20 \text{ В}$, $I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}$)	$h_{11\text{с}}$	70		70		70		70	

ШТАМП ОТК

ШТАМП

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА



УПАКОВЩИК №13

12 12.85